

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup podłoży InAs do produkcji struktur półprzewodnikowych metodą MBE

Podłoża InAs do wzrostów epitaksjalnych metodą MBE – 10 sztuk.

Materiał podłoża – InAs o średnicy 2 cale

Średnica – ok. 50.5 μm

Grubość - ok. 500 μm

Orientacja – (100)

Dwustronnie polerowany

Domieszkowanie - typ N

Koncentracja nośników – od 1 do 3 x 10¹⁶ cm⁻³